

# マイクロチップレーザー 技術移管の製品仕様 (計画)

	開発目標 (最終仕様)	技術移管する製品仕様
レーザー構成	発振器 または 発振器 + 増幅器	発振器
ピーク出力	約50MW(最大500MW)	約25MW
平均出力	約2W (最大10W)	約1W
レーザー波長	1064nm (118nm~300μmまで設計可)	1064nm
パルスエネルギー	20 mJ/pulse (最大100mJ/pulse)@1064nm	10~20mJ/pulse@1064nm
パルス幅(FWHM)	400ps~1ns (100ps~10nsまで設計可能)	400ps
繰り返し周波数	100Hz	50~100Hz
出射ビーム径	約φ0.5~1mm (発振器直後)	約φ0.5~1mm
偏 光	直線偏光 (偏光比>100:1)	直線偏光 (偏光比>100:1)
ビーム品質M <sup>2</sup> 値	<2	<2
装置寸法	≤20mJ (発振器のみ、空冷時) ヘッド部 : W100 x D150 x H60mm 電源部 : 19inchラック(3U~4U)	ヘッド部 : W100×D150×H60mm 電源部 : W210×D310×H150mm (LD内蔵)
重 量	ヘッド部 <1kg (≤20mJ (空冷時) )	ヘッド部 <1kg、 電源部 <10kg
電源容量	~100W (<20mJ (空冷時) )	<100W
冷 却	空冷(≤20mJ) または 水冷(>20mJ)	空冷 (ヘッド部)
耐環境温度	10-30℃ (結露なきこと)	10-30℃
特 長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サブナノ秒パルスレーザー</li> <li>・ヘッド姿勢に因らず使用可能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サブナノ秒パルスレーザー</li> </ul>